

Embedded Lösungen



PCIe M.2 SSDs

MTE662T2

Transcends MTE662T2 M.2 SSD nutzt die PCI Express (PCIe) Gen 3 x4-Schnittstelle und ist kompatibel mit den NVM Express (NVMe) 1.3-Spezifikationen, um besonders hohe Übertragungsgeschwindigkeiten zu erreichen. Die MTE662T2 verfügt über die hochmoderne 3D-NAND-Technologie, die es ermöglicht, 96 Schichten von 3D-NAND-Flash-Chips vertikal zu stapeln. Dies ermöglicht im Vergleich zu 3D-NAND mit 64 Schichten eine deutlich höhere Speichereffizienz. Der integrierte DRAM-Cache sorgt zusätzlich für einen schnellen Zugriff. Dank 30µ"-Goldkontakten und Corner Bond-Technologie sowie angesichts der vollumfänglichen hausinternen Tests garantiert die MTE662T2 Zuverlässigkeit in unternehmenskritischen Anwendungen. Die SSD verfügt über eine Haltbarkeit von 3K-Schreib-/Löschzyklen und kann im erweiterten Betriebstemperaturbereich von -20°C bis 75°C eingesetzt werden.

Hardware-Eigenschaften

- Ausdauer: 3K P/E-Zyklen (Program/Erase Zyklen) garantiert
- 30µ" PCB-Goldkontakte
- Schlüsselkomponenten sind standardmäßig mit Corner Bond Technologie verstärkt
- mit DDR4 DRAM Cache
- Gesicherte Betriebssicherheit in einem erweiterten Temperaturbereich (von -20°C bis 75°C)

Bestellinformationen

512GB	TS512GMTE662T2
1TB	TS1TMTE662T2
2TB	TS2TMTE662T2

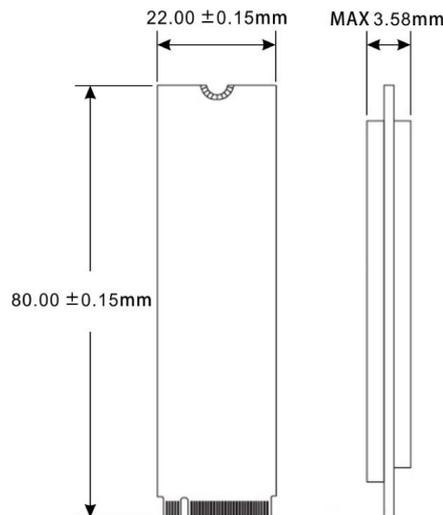
Firmware-Eigenschaften

- SLC Caching-Technologie
- NVM command
- Eingebaute LDPC ECC (Error Correction Code) Funktionalität
- Dynamisch-thermische Drosselung
- Verbesserte S.M.A.R.T.-Funktion für besondere Langlebigkeit

Technische Daten

Erscheinungsbild	Abmessung	80 mm x 22 mm x 3.58 mm (3.15" x 0.87" x 0.14")
	Gewicht	9 g (0.32 oz)
	Formfaktor	M.2
	M.2	2280-D2-M (Beidseitig bestückt)
Verbindungsschnittstelle	Verbindungsschnittstelle Bus	NVMe PCIe Gen3 x4
Speicher	Flash-Typ	3D NAND Flash
	Kapazität	512 GB / 1 TB / 2 TB
Betriebsumgebung	Betriebsspannung	3,3V ± 5%
	Betriebstemperatur	Erweiterter Temp. -20°C (-4°F) bis 75°C (167°F)
	Lagertemperatur	-55°C (-67°F) bis 85°C (185°F)
	Feuchtigkeit	5% ~ 95%
	Erschütterung	1500 G, 0,5 ms, 3 axis
Strom	Erschütterung (in Betrieb)	20 G (Spitzenwerte), 7 Hz ~ 2000 Hz (Frequenz)
	Stromverbrauch (in Betrieb)	7.0 Watt
Performance	Stromverbrauch (IDLE)	1.0 Watt
	Max. sequenzielle Lese-/Schreibgeschwindigkeit (CrystalDiskMark)	Lesen: Bis zu 3,500 MB/s Schreiben: Bis zu 2,700 MB/s
	Max. zufällige 4K Lese-/Schreibgeschwindigkeit (IOmeter)	Lesen: Bis zu 340,000 IOPS Schreiben: Bis zu 355,000 IOPS
	Durchschnittliche Zeit zwischen zwei Ausfällen (MTBF)	3,000,000 Stunde(n)
	Max. TeraBytes Written	4,400 TBW
Garantie	Schreibzyklen pro Tag (DWPD)	2 (3 Jahre)
	Zertifikate	CE / FCC / BSMI
	Garantie	3 Jahre bedingte Garantie

Mechanische Abmessungen



Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Die gezeigten Bilder können von den tatsächlichen Produkten abweichen. Die insgesamt verfügbare Kapazität variiert je nach Betriebsumgebung. Aufgrund der Komplexität und Vielfalt der industriellen Anwendungen kann Transcend keine 100%ige Kompatibilität mit allen Plattformen und unter allen Szenarien garantieren. Für spezielle Anwendungen und Umgebungen wird dringend empfohlen, sich vorher zur Klärung mit Transcend in Verbindung zu setzen.